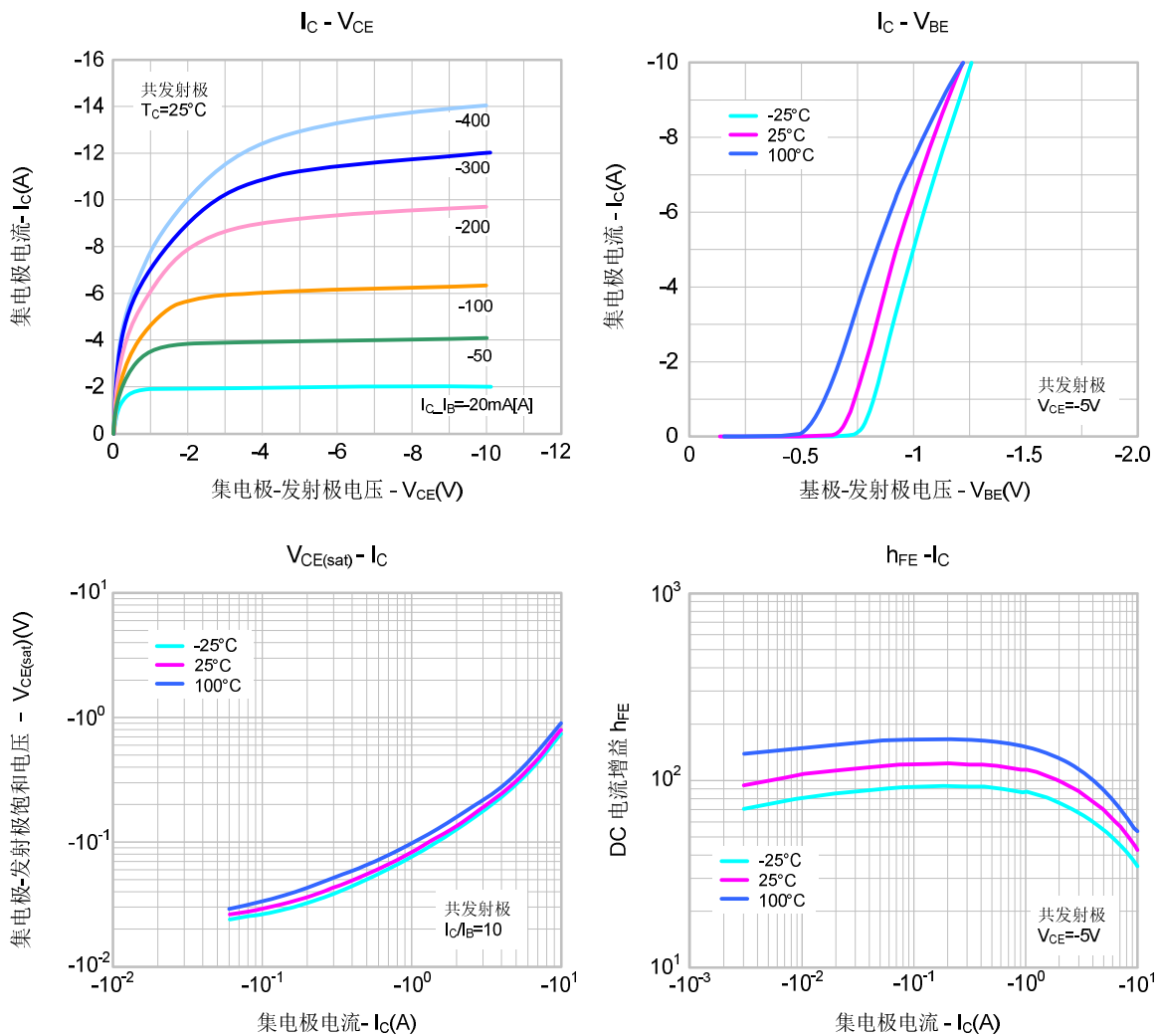
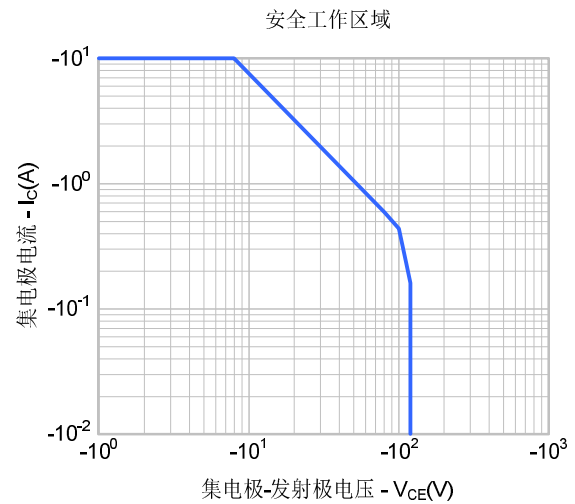
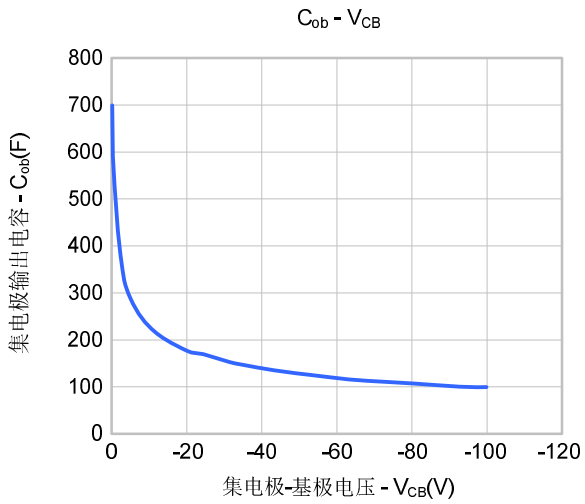
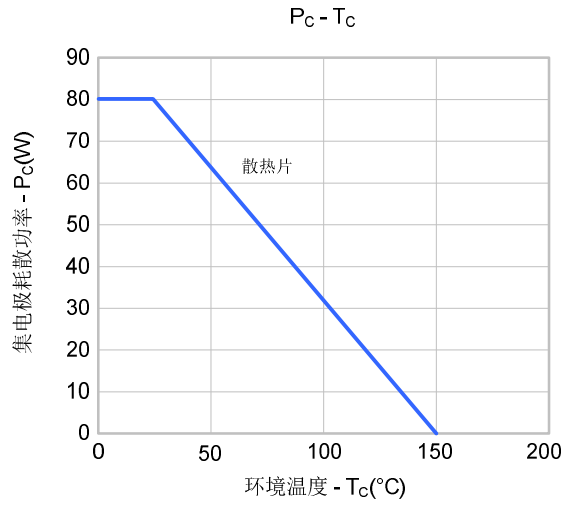
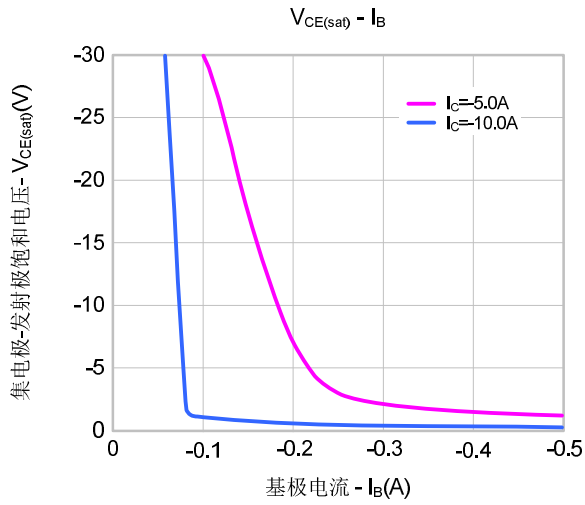


电参数(除非特殊说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型	最大值	单位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$	55	-	160	-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-6\text{A}, I_B=-0.6\text{A}$	-	-	-2	V
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-5\text{A}$	-	-	-1.5	V
集电极、基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-120\text{V}, I_E=0$	-	-	-10	μA
集电极、发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-120\text{V}, I_B=0$	-	-	100	μA
发射极、基极漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	-	-	-10	μA
三极管频率	FT	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$	-	10	-	MHZ
集电极输出电容	C_{Ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	230	-	pF

典型特性曲线


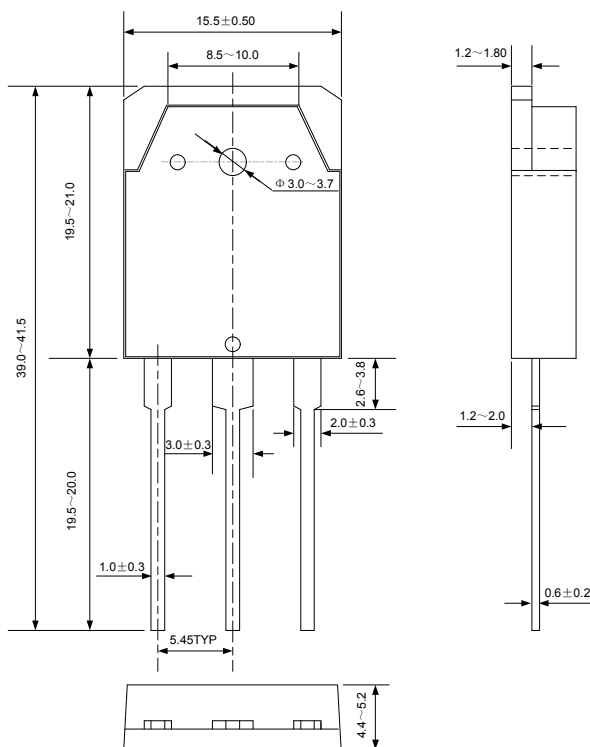
典型特性曲线 (续)



封装外形图

TO-3P

单位：毫米



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SJT688APPN	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.0	作 者:	殷资
------	-----	------	----

修改记录:

1. 正式发布版本
-